PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

No.1

(11)Publication number:

08-295955

(43)Date of publication of application: 12.11.1996

(51)Int.CI.

C22B 5/02 C22B 34/12

(21)Application number: 07-129428

(71)Applicant: SUMITOMO SITIX CORP

(22)Date of filing:

27.04.1995

(72)Inventor: ARAIKE TADAO

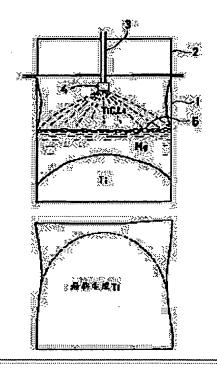
SHIMOZAKI SHINJI

(54) METHOD FOR REDUCING HIGH MELTING POINT METAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To facilitate the temp. control at the time of reducing a high m.p. metal chloride with Mg to form the high m.p. metal, to enhance the reaction efficiency, to lower the bulk density of the formed material and to increase the yield per batch.

CONSTITUTION: A liq. chloride introduced into a reaction vessel 1 through a pipe 3 is formed into a fine liq. droplet by a nozzle 4 fixed to the lower end of the pipe 3. The chloride is supplied and dispersed practically over the whole reaction face 5 where the molten Mg is present. The nonuniform reaction is not caused on the reaction face 5, and the reaction face 5 is effectively utilized.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.04.2000

[Date of sending the examiner's decision of

04.11.2003

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公園番号

特開平8-295955

(43)公開日 平成8年(1996)11月12日

(51) Int.CL*		識別記号	庁内整理番号	FΙ		·	技術表示箇所
C 2 2 B	5/02			C 2 2 B	5/02		
	34/12	103			34/12	103	

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 4 頁)

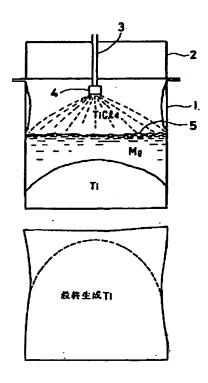
		・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
(21)出願番号	特顧平7-129428	(71) 出顧人 000205351
		住友シチックス株式会社
(22) 出顧日	平成7年(1995)4月27日	兵庫県尼崎市東浜町1番地
		(72)発明者 荒池 忠男
	•	兵庫県尼崎市東浜町1番地 住友シチック
		ス株式会社内
		(72)発明者 下崎 新二
		兵庫県尼崎市東浜町1番地 住友シチック
		ス株式会社内
		(74)代理人 弁理士 生形 元重 (外1名)

(54) 【発明の名称】 高融点金属塩化物の還元方法

(57)【要約】

【目的】 高融点金属の塩化物をMgにより還元して高 融点金属を生成する際の温度制御を容易にする。反応効 率を高める。生成金属のバルク密度を低下させる。1バ ッチ当りの生産量を高める。

【構成】 パイプ3により反応容器1内に導入される液状の塩化物を、パイプ3の下端に取付けたノズル4により細かい液滴にする。溶融Mgが存在する反応面5のほぼ全体に前記塩化物を分散供給する。反応面5での反応の偏りが解消し、反応面5が有効利用される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 高融点金属の塩化物をMgにより還元し て高融点金属を製造する際に、反応容器内に上方から導 入される液状の塩化物を、溶融Mgが存在する反応面に 分散供給することを特徴とする高融点金属塩化物の還元 方法。

1

【請求項2】 反応容器内の中心部に上方から挿入され る塩化物滴下パイプの下端に、内部を通過する塩化物に 旋回力を与えて1つの大径流出孔から下方に排出するノ ズルを取り付け、前記滴下パイプを通して前記ノズルに 10 を、溶融Mgが存在する反応面に分散供給するものであ 塩化物を圧送するととにより、その塩化物を前記大径流 出孔から飛散噴出させることを特徴とする請求項1に記 載の高融点金属塩化物の還元方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、スポンジTi等の製造 に用いられる髙融点金属塩化物のMgによる還元方法に 関する。

[0002]

【従来の技術】金属Tiの溶製素材として使用されるス 20 使用不能となるおそれがある。 ポンジTiは、TiCl、等のTi塩化物をMgにより 還元する方法により製造される。TiCl、を用いたM g還元による従来のスポンジTi 製造法を図1により説 明する。

【0003】反応容器1内にMgを封入し、これを溶融 温度以上に加熱した後、滴下パイプ3により、溶融Mg で満ちた反応面5に液状のTiCl、を滴下供給する。 ととで、滴下パイプ3は、反応容器1の上面開口部を閉 止する蓋2の中心部に垂直に取り付けられている。 との 滴下パイプ3により反応面5の中央部に供給されたTi Cl.がMgにより還元され、この還元反応が進むこと により、反応容器1内の底面上にスポンジTiが生成し て行く。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】とのような従来の還元 方法によると、反応面の中央部にTiCl。が滴下供給 されることに関連して、次のような問題がある。

【0005】TiCl。とMgの反応は発熱反応である ため、TiCl。の供給される反応面の中央部で局所的 な温度異常が生じるととがあり、反応容器の外から行う 温度制御ではその制御が難しい。

【0006】反応面の中央部で反応が促進されるため、 反応容器 1 内の底面上に生成するスポンジT i は上方に 尖った山形となる。一方、反応面から生じるMg蒸気が TiCl。の蒸気と反応して反応面より上方の容器内面 にもスポンジTiが生成する。そのため、最終的に得ら れるスポンジTiの形状は外周面がくびれ上面が窪んだ ものになる。その結果、1バッチあたりの生産量が制限 される。

【0007】また、スポンジTiの中心部では副生物で 50

あるMgCl、の抜けが悪くなり、バルク密度が上が る。反応面の中央部に反応が偏ることから、反応効率も 制限されると考えられる。

【0008】本発明の目的は、これらの問題点を解決す る高融点金属塩化物の還元方法を提供することにある。 [0009]

【課題を解決するための手段】本発明の方法は、髙融点 金属の塩化物をMgにより還元して高融点金属を製造す る際に、反応容器内に上方から導入された液状の塩化物 る。

【0010】図2は本発明方法の典型的な例を模式的に 示すものである。

【0011】蓋2の中心部に垂直に設けた滴下パイプ3 の下端にノズル4を取り付け、液状のTiCl』を細か い液滴にして反応面に分散供給する。ノズル4として は、シヤワーノズルのように小さい流出孔を多数設けた ものが考えられるが、そのような多孔ノズルは、たとえ TiCl、を圧送したとしても孔づまりにより短期間で

【0012】そのため、図3(A)(B)に示すよう に、圧送されるTiCl。をノズル内で旋回させ、ノズ ル下面に開口する1つの下向きの大径流出孔から遠心力 によってTiCl、を飛散噴出させる旋回噴出型のもの が望ましい。図3(A)に示されたノズルでは、水平な 流入路4aを垂直な流出路4bと交差させ、その交差部 で流入路4 aを流出路4 b に対して偏心させることによ り、TiCl、流に旋回力を与える。また、図3(B) に示されたノズルでは、垂直な流路4 c に設けられた螺 旋羽根4dによりTiCl.流を旋回させる。

【0013】とのような旋回噴出型のノズルを用いる と、1つの下向き大径流出孔からTiCl。が強制排出 されるため、TiC1、を分散供給するにもかかわら ず、閉塞率が滴下パイプによる場合よりも更に低下す る。

【0014】なお、簡単なものとしては、図3(C)に 示すように、外周面の周方向に間隔をあけて比較的小数 大径の流出孔をあけたノズル4を使用することもできる し、同様の考えから滴下パイプを複数本に分け、各パイ プを分散配置することも可能である。いずれにしても、 シヤワーノズルのように小さい流出孔を多数設けたもの は適当ではない。

[0015]

【作用】本発明の還元方法においては、反応面に塩化物 が分散供給されるため、反応面での反応の偏りが緩和さ れ、局所的な温度異常およびパルク密度の増大が避けら れるだけでなく、反応効率が上がり、更には最終的に得 られるスポンジ金属の表面変形が級和され、1パッチ当 りの生産量も増加する。

【0016】ととで特に注目すべきととは、生成金属表

3

面の変形緩和である。図2に示すように、反応面5に塩化物を分散供給することにより、反応容器1内の底面上に生成するスポンジ金属はその上面が平坦化されるが、それだけではなく反応面5より上方の容器内面においてスポンジ金属の生成が抑制され、その結果、最終生成金属の外周面および上面において窪みが著しく減少する。容器内面においてスポンジ金属の生成が抑制される理由は定かでないが、本発明者らは一応、塩化物の分散供給により反応面5からのMg蒸気の上昇が抑制されるためと考えている。

【0017】反応面への塩化物供給範囲は、反応面の全体とすることが最良である。但し、実際の操業では、還元開始から還元終了まで反応面の全体に塩化物を分散供給し続けることは困難である。これは塩化物の分散範囲を一定にしても、還元の進行につれて反応面が上昇し塩化物の供給範囲が狭くなるからである。そのため、還元*

*中の各時期において反応面の出来るだけ広い範囲に塩化物が分散供給されるように当初の分散範囲を決定し、更に必要に応じて操業中に操業に支障を来さない範囲内で操業条件を操作することが望まれる。

[0018]

【実施例】以下に本発明の実施例を示し、従来例と比較 することにより、本発明の効果を明らかにする。

【0019】TiCl、を用いたMg 還元により表1に 示す条件でスポンジTiを製造する際に、反応容器の中 心部に配置された1本のTiCl、滴下バイブの下端に 図2(A)(B)に示すノズルを装着し、TiCl、を 圧送することにより、反応面のほぼ全体にTiCl、を 分散供給した。

[0020]

【表1】

TiCl。の目標供給総量	45,000kg			
TiCl。の平均流速	0.11~0.13 (kg/s)			
反応制御温度	1, 1 0 0~1, 2 0 0 (k)			

【0021】いずれのノズルを用いた場合も、ノズルを 装着せずパイプからTiCl。を滴下供給した場合と比 べて次の効果を得ることができた。

【0022】局所的な(主に中心部での)温度異常が減少し、温度制御が容易になった。

【0023】TiCl、を圧送するととにより、ノズルの流出孔に新鮮なTiCl、が常時存在し、とれによる 30 自冷効果により、流出孔の閉塞率が5%から2%に減少した。

【0024】最終的に得られるスポンジTiの外周面のくびれが小さくなり、上面の窪みも小さくなった結果、1パッチ当りの生産量が平均で11Tから11.3Tに3%増大した。

【0025】反応面の有効利用により、生成速度を平均で37.5 T/M・Fから40T/M・Fへ約7%向上させることができた。

【0026】生成するスポンジTiの中心部においても 40 副生物であるMgCl,の除去が促進され、その結果バルク密度が平均で1.6から1.55へ低下した。

[0027]

【発明の効果】以上に説明した通り、本発明の高融点金

属塩化物の還元方法は、溶融Mgが存在する反応面に塩化物を分散供給することにより、温度制御を容易ならしめると共に、反応効率を高め、更にパルク密度を低下させることができる。その上、生成金属の形状を整え、1パッチ当りの生産量を高めることもできる。

【0028】滴下パイプの下端に旋回噴出型のノズルを 取り付け、そのノズルに塩化物を圧送する場合は、塩化 物を分散供給するにもかかわらず、滴下パイプからの滴 下供給の場合よりも更に閉塞率が低下する。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来の還元方法を示す模式図である。

【図2】本発明の還元方法の1例を示す模式図である。

【図3】本発明の還元方法に好適に使用されるノズルの 形状を示す模式図である。

【符号の説明】

- 1 反応容器
- 10 2 蓋
 - 3 滴下パイプ
 - 4 ノズル
 - 5 反応面

4

